11.3. ОДНОВИБРАТОРЫ

Одновибраторы используются для получения прямоугольных импульсов напряжения большой длительности (от десятков микросекунд до сотен миллисекунд), в качестве устройств задержки, делителей частоты и для других целей. Одновибратор обладает одним устойчивым состоя-

нием, в котором может находиться сколь угодно долго, пока к нему не будет приложено внешнее напряжение, переводящее его в квазиустойчивое состояние. Переход из квазиустойчивого состояния в устойчивое осуществляется в одновибраторе самостоятельно.

Одновибраторы на дискретных элементах. Одновибратор можно получить из автоколебательного мультивибратора, если одно из его квазиустойчивых состояний превратить в устойчивое. На рис. 11.5, *а* показана схема

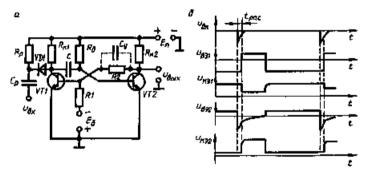


Рис. 11.5. Схема одновибратора на БТ с коллекторно-базовыми связями (а) и графики напряжений на электродах транзисторов (б)

одновибратора с коллекторно-базовыми связями, а на рис. 11,5, σ временные диаграммы напряжений, поясняющие его работу. Резисторы R1, R2 и R_{x2} выбираются такими, что на-

пряжение между базой и эмиттером транзистора VT1 оказывается отрицательным. Поэтому в исходном состоянии этот транзистор закрыт. На базу транзистора VT2 через резистор R_6 подается положительное напряжение. Транзистор VT2 вследствие этого открыт и насыщен.

Входной отрицательный импульс через разделительную цепь $C_{\mathsf{p}}R_{\mathsf{p}}$ и отсекающий диод VDJ подается на базу транзистора VT2. Ввиду накопленных в базе зарядов неосновных носителей транзистор VT2 не может сразу закрыться,

и начинается процесс рассасывания неосновных носителей. Через время $t_{\rm pac}$ транзистор VT2 окажется на границе режима насыщения и под действием отрицательного входного импульса, приложенного к базе VT2, коллекторный ток транзистора VT2 начнет уменьшаться, а коллекторное напряжение $u_{\rm K32}$ — увеличиваться. Увеличение напряжения $u_{\rm K32}$ через делитель R2R1 передается на базу транзистора VT1. Чтобы увеличить коэффициент передачи делителя, не нарушая исходного состояния, резистор R2 можно шунтировать конденсатором $C_{\rm y}$ небольшой емкости, который называется ускоряющим.

Под действием ПОС, приводящей к лавинообразному процессу изменений токов и напряжений транзисторов:

транзистор VT2 запирается, а транзистор V отпирается и переходит в режим насыщения. Наступает квазиустойчивое состояние равновесия.

После отпирания транзистора VT1 конденсатор С оказывается включенным между базой и эмиттером транзистора VT2, причем $u_{532} = -u_C$. Начинается перезарядка конденсатора C по цепи: $+E_n \rightarrow R_6 \rightarrow C \rightarrow VT1 \rightarrow -E_n$. Перезарядка сопровождается уменьшением отрицательного напряжения на конденсаторе и на базе транзистора VT2. При этом напряжение $u_{K31} \approx 0$, а $u_{K32} \approx E_n - (E_n + E_0)R_{n2}/(R1 + R2 + R_{n2})$.

Как только напряжение на конденсаторе достигнет нулевого уровня, рабочая точка, характеризующая режим транзистора VT2, окажется на границе с активной областью. При дальнейшем увеличении напряжения $u_{\mathcal{C}}$ рабочая точка перейдет в активную область и замкнется цепь положительной OC:

$$\begin{array}{c}
\downarrow i_{K2} \uparrow \rightarrow u_{K32} \downarrow \rightarrow u_{E31} \downarrow \rightarrow i_{K1} \downarrow \rightarrow u_{K31} \uparrow \rightarrow u_{E32} \uparrow \rightarrow \downarrow \\
\uparrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow
\end{array}$$

Транзистор VT1 закроется; а VT2 откроется и будет находиться в режиме насыщения. Начнется зарядка конденсатора C по цепи: $+E_n \rightarrow R_{K1} \rightarrow C \rightarrow VT2 \rightarrow -E_n$. После зарядки конденсатора C одновибратор будет находиться в устойчивом состоянии до прихода следующего входного (запускающего) импульса, т. е. в режиме ожидания. Поэтому одновибратор часто называют ждущим мультивибратор ом.

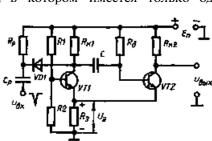
Длительность формируемого одновибратором импульса определяется постоянной времени цепи перезарядки конденсатора C и может быть приближенно определена по формуле

 $t_{\rm H} \approx 0.7 R_{\rm B} C$.

Недостатком рассмотренного одновибратора является

(11.4)

использованиевнемдвух источников E_n и E_5 . Поэтому чаще применяется одновибратор с эмиттерной связью (рис. 11.6), в котором имеется только один источник



 $Puc.\ 11.6.\$ Схема одновибратора на БТ с эмиттерной связью питания E_{n} . Роль источника E_{6} , обеспечивающего запи

рание транзистора VT1 в исходном состоянии, выполняет напряжение U_3 на резисторе R_3 , создаваемое эмиттерным током открытого и насыщенного транзистора VT2. Ток базы насыщенного транзистора VT2 определяется сопротивлением резистора R_{6} , а ток коллектора — сопротивлением резистора R_{1} , Сопротивления резисторов R1, R2 и R_3 рассчитываются таким образом, чтобы в исходном состоянии напряжение u_{69} транзистора VT1 было отрицательным, т. е.

$$u_{\mathrm{B}31}=E_{\mathrm{u}}R2/(RI+R2)-U_{\mathrm{B}}<0,$$
 (11.5) где $U_{\mathrm{B}}=I_{\mathrm{B}2\,\mathrm{mac}}$ $R_{\mathrm{B}1}$ $I_{\mathrm{B}2\,\mathrm{mac}}=-$ эмиттерный ток транзистора

VT2 в режиме насыщения.

Одновибраторы на логических элементах. На рис.

11.7, a представлена схема одновибратора на логических элементах $\mathbf{U} - \mathbf{HE}$. . В исходном состоянии на входе ЛЭ1 действует на-

пряжение высокого уровня — логическая единица. Напряжение на входах ЛЭ2 равно напряжению на резисторе R, которое создается на нем входным током ЛЭ2. Так как $I_{\rm sx}R < u_{\rm nop}^{\rm 0}$, то можно считать, что на входах ЛЭ2 имеется логический нуль, а на выходе — логическая единица, ко-

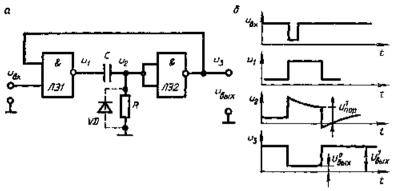


Рис. 11.7. Схема одновибратора на логических элементах (а) и графики изменений напряжений на входах и выходах ЛЭ (б)

торая передается на второй вход Л91. Таким образом, на каждом входе Л91 имеется логическая единица. Следовательно, Л91 открыт и напряжение на его выходе соответствует логическому нулю. Напряжение на конденсаторе C также близко к нулю.

При поступлении на вход отрицательного импульса, соответствующего логическому нулю, на выходе ЛЭ1 устанавливается логическая единица, соответствующая напряжению высокого уровня. Начинается зарядка конденсатора С. Ток зарядки протекает от выхода ЛЭ1 через конденсатор C и резистор R. На резисторе создается положительное напряжение $u_R = i_{C \text{ зар}} R > U_{\text{пор}}^I$, которое в виде логической единицы поступает на входы ЛЭ2 и открывает его. На выходе ЛЭ2 образуется низкое напряжение (логический нуль), которое передается на второй вход ЛЭ1 и поддерживает его в закрытом состоянии после прекращения действия входного импульса.

По мере зарядки конденсатора С напряжение u_R на резисторе R уменьшается. При $u_R < U^l_{\text{пор}}$ дальнейшее уменьшение u_R будет сопровождаться увеличением напряжения U_3 на выходе ЛЭ2 и на втором входе ЛЭ1. Начнет действовать положительная ОС, которую можно представить следующей символической записью:

При $u_3 > U_{\text{пор}}^1$ на обоих входах ЛЭ1 будет логическая единица, ЛЭ1 откроется и на его выходе напряжение уменьшится до логического нуля. Начнется разрядка

Графики напряжений на входах и выходах логических элементов показаны на рис. 11.7, б. Они построены без учета задержек при переключениях одновибратора.

Одновибраторы на операционных усилителях. Принципиальная схема одновибратора на ОУ (рис. 11.8, *a*)

конденсатора C через выходное сопротивление ЛЭ1 и диод VD. Напряжение u_2 на входах ЛЭ2 станет меньше порогового $U_{\text{пор}}^0$ и ЛЭ2 закроется. В таком состоянии

следующего

устройство будет находиться до прихода

запускающего импульса.



конденсаторе, входе и выходе одновибратора (6) отличается от схемы мультивибратора на ОУ (рис. 1 1.4, *a*)

наличием диода *VD*, подключенного параллельно конденсатору С. При указанном на схеме направлении включения диода в исходном состоянии на выходе устанавливается минимальный (отрицательный) уровень напряже-

ния $U_{\text{вых min}}$. Пиод VD, образующий с резистором R3 делитель

близко к нулю и $u_c = u_{\rm ax}^{(-)} \simeq 0$. Напряжение на неинвертирующем входе равно $u_{\rm bx}^{(+)} = U_{\rm obs x nuin} R1/(R1 + R2)$. Графики напряжений, поясняющие работу одновибра-

выходного напряжения, оказывается включенным в прямом направлении, поэтому падение напряжения на нем

тора, приведены на рис. 11.8, б. При поступлении на вход импульса положительной подприости. С амилитулой предприости с амилитулой предприости.

при поступлении на вход импульса положительной полярности с амплитудой, превышающей значение $U_{\text{вых min}} RI/(RI + R2)$, напряжение на неинвертирующем

входе становится положительным. Под действием $u_{nx}^{(+)} > 0$ напряжение на выходе также становится положительным и, поступая на неинвертирующий вход через

ного значения $U_{\text{вых так}}$. Напряжение на неинвертирующем входе принимает значение $u_{\rm ax}^{(+)} = U_{\rm BMX\,max}\,R1/(R1+R2).$

делитель R1R2, лавинообразно нарастает до максималь-

$$u_{\rm ax}^{\rm ver} = U_{\rm amx\,max}\,R1/(R1+R2).$$

Под действием напряжения $U_{\text{вых спях}}$ конденсатор Cначинает заряжаться через резистор R3. Диод VD вклю-

чается в обратном направлении и на процесс зарядки влияния не оказывает. Пока $u_{c} < u_{ex}^{(+)}$, напряжение $u_{\text{вых}} = U_{\text{вых max}}$. При приближении u_c к $u_c^{(+)}$ ОУ выходит из режима насыщения и при $u_c > u_{\text{вх}}^{(+)}$ 'под действием положительной ОС, осуществляемой через делитель R1R2, происходит второе «опрокидывание», в результате которого на выходе устанавливается минимальное напряжение $U_{\text{вых mul}}$. Конденсатор начинает разряжаться через резистор R3 и $R_{\text{вых}}$ ОУ. При достижении напряжения на конденсаторе нулевого уровня диод открывается

и процесс разрядки конденсатора заканчивается. Таким образом, на выходе одновибратора на ОУ формируется положительный импульс с крутыми фронтами, длительность которого можно рассчитать по формуле

 $t_0 \approx C R3 \ln (1 + R1/R2)$. (11.6)Если изменить направление включения диода, то изменится полярность выходного импульса. При этом запуск одновибратора должен производиться входными

импульсами отрицательной полярности.